

ALD(原子層堆積)/ALE(原子層エッチング)技術の基礎と応用

- ◆日時: 2021年12月20日(月) 10:30~16:30
 - ◆会場: 【WEB限定セミナー】※在宅、会社にながらセミナーを受けられます
 - ◆聴講料: 1名につき55,000円(税込、資料付)
- ※会員登録(無料)をしていただいた方には下記の割引・特典を適用します。
- ・1名でお申込みされた場合、1名につき**49,500円(税込)**
 - ・2名同時申込で両名とも会員登録をしていただいた場合、計74,250円(税込)(2人合計)です。

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

●講師: 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究領域 情報機能素子科学研究室 教授 博士(工学)浦岡 行治 氏

AIや5GなどIoT技術の進歩を支えている半導体加工技術において、高機能な薄膜を形成することは、非常に重要である。薄膜形成技術については、古くからいろいろな手法が開発され、LSI、ディスプレイ、太陽電池などのエレクトロニクスの分野で広く活用されてきた。本セミナーでは、近年、特に注目を浴びているALD(原子層堆積)/ALE(原子層エッチング)技術について、その基礎と応用について概説する。特に、堆積の原理や材料について詳しく紹介する。また、LSI、薄膜トランジスタ、パワーデバイスに応用した時の特長や課題についても紹介する。

1. 薄膜形成技術

- 1.1 薄膜作製/加工の基礎
- 1.2 薄膜の評価手法
 - 1.2.1 電気的評価
 - 1.2.2 化学的分析手法
 - 1.2.3 光学的評価手法

2. ALD/ALE技術の基礎

- 2.1 ALD技術の原理
- 2.2 ALD薄膜の特長
- 2.3 ALD技術の歴史
- 2.4 ALD装置の仕組み

2.5 ALD技術の材料

- 2.6 ALE技術の基礎
- 2.7 ALE技術の課題

3. ALD/ALE技術の応用

- 3.1 パワーデバイスへの応用
- 3.2 酸化物薄膜トランジスタへの応用
- 3.3 MOS LSIへの応用
- 3.4 太陽電池への応用

4. ALD/ALE技術の将来

- 4.1 ALD/ALE技術の課題
- 4.2 ALD/ALE技術の展望

『ALD【WEBセミナー】』セミナー申込書

会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	

お名前	所属・役職	E-Mail
①		
②		

会員登録(無料) ※案内方法を選択してください。複数選択可。

Eメール 郵送

● Webセミナーの受講申込みについて ●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたしまして、別途視聴用のURLをメールにお送りいたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>



株式会社 R & D 支援センター

〒135-0016 東京都江東区東陽3-23-24 VORT東陽町ビル7階
TEL) 03-5857-4811 FAX) 03-5857-4812 URL) <https://www.rdsc.co.jp/>